

Spezifikationen	
Teilenummer	1N3070_T50R
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 500MA DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	2656 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 100mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	175°C (Max)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 500mA Through Hole DO-35
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 175V
Strom - Richt (Io)	500mA
Kapazität @ Vr, F	5pF @ 0V, 1MHz
Basisteilenummer	1N3070

sein:

1N3070_500R
Fairchild/ON Semiconductor
DIODE GEN PURP 200V 500MA
DO35

 1N3070UR-1 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 175V 100MA DO7	 1N3070TR Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 500MA DO35	 1N3070UR-1 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 175V 100MA DO7
 1N3070 AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 500MA DO35	 1N3085R IR IR New	 1N3087R Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 300V 150A DO205AC

Mehr

1N3070_T50R ON Semiconductor / ON Semiconductor	1N3070_T50R Datenblatt	1N3070_T50R-Datenblätter	1N3070_T50R PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 1N3070_T50R
1N3070_T50R Electronic	1N3070_T50R-Komponenten	1N3070_T50R-Verteiler	1N3070_T50R-Bild	1N3070_T50R-Teil
1N3070_T50R Preis	1N3070_T50R Hersteller	1N3070_T50R Bild	1N3070_T50R Aktie	1N3070_T50R Inventar
1N3070_T50R Neu	1N3070_T50R Original	1N3070_T50R garantiert	1N3070_T50R RFQ	1N3070_T50R Online bestellen